








	<h2>SIHP8N50D-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHP8N50D-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.SIHP8N50D-E3.pdf</li> <li>2.SIHP8N50D-E3.pdf</li> <li>3.SIHP8N50D-E3.pdf</li> </ul> </p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHP8N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 8.7A (Tc) 156W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	527pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP8N50D-E3CT

SIHP8N50D-E3 ist neu im Original, Suche SIHP8N50D-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP8N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP8N50D-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHP7N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP7N60E-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP7N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>	 <p><b>SIHP7N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>
 <p><b>SIHS20N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 20A TO-247AD</p>	 <p><b>SIHS20N50C-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 20A TO-247AD</p>	 <p><b>SIHP8N50D-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>	 <p><b>SIHP8N50D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SIHFSL11N50A	➔ SIHG16N50C-E3	➔ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	➔ SIHG20N50C
⊣ SIHG22N60S-E3	⚙ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	➔ SIHG47N60E-E3	➔ SIHG47N60E-E3
⚙ SIHG47N60E-GE3	⊣ SIHG47N60E-GE3	⚙ SIHG47N60S-E3	➔ SIHG70N60EFEF-GE3	➔ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⚙ SIHP10N40D	⊣ SIHP12N50C-E3	⚙ SIHP12N50C-E3	➔ SIHP12N60E-E3
➔ SIHP12N60E-E3	➔ SIHP12N60E-GE3	⚙ SIHP12N60E-GE3	⊣ SIHP12N65E	➔ SIHP14N50D
➔ SIHP15N60E-E3	➔ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	⚙ SIHP16N50C-E3	⊣ SIHP16N50C-E3
⚙ SIHP17N60D-E3	D SIHP17N60D-E3	➔ SIHP18N50C-E3	➔ SIHP18N50C-E3	➔ SIHP22N60S-E3
⊣ SIHP30N60E-E3	⚙ SIHP30N60E-E3	➔ SIHP30N60E-GE3	➔ SIHP30N60E-GE3	➔ SIHP30N60E-GE3
⚙ SIHP33N60E-GE3	⊣ SIHP33N60E-GE3	⚙ SIHP5N50D-E3	D SIHP5N50D-E3	➔ SIHP6N40D
➔ SIHP8N50D-E3	⚙ SIHU3N50D-E3	⊣ SIHU3N50D-E3	⚙ SIHW30N60E-GE3	➔ SIHW30N60E-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

